固体辐射物理研究室知识库

一种基于SOI结构的电离总剂量探测系统及方法

孙静[1]; 郭雄[1]; 施炜雷; 于新; 何承发[1]; 余学峰[1]; 陆妩[1]

2017-06-06

专利权人	中国科学院新疆理化技术研究所
授权日期	2019-05-31
专利类型	发明专利
摘要	本发明涉及辐射环境探测技术领域，涉及一种基于SOI结构的电离总剂量探测系统及方法。该探测系统包括探头模块、恒流源模块、数据采集模块和控制模块；所述控制模块输入端与PC机相连，控制模块输出端与恒流源模块、数据采集模块和探头模块相连；所述恒流源模块与探头模块相连；所述数据采集模块的输入端与探头模块相连，数据采集模块的输出端与PC机相连；所述探头模块包括SOI结构的辐照传感器。本发明实现了采用PMOS剂量计的传感器国产化；提高了灵敏度，可用于更低累积剂量的测试；基于此结构的探测器便携、灵活、易用，适用于空间环境监测、半导体元器件电离效应评估及寿命预测。
申请日期	2016-12-19
专利状态	已授权
申请号	CN201611177450.3
公开（公告）号	CN106802427B
代理机构	西安智邦专利商标代理有限公司 61211
文献类型	专利
条目标识符	http://ir.tianshanzw.cn/handle/365002/6577
专题	固体辐射物理研究室
推荐引用方式 GB/T 7714	孙静,郭雄,施炜雷,等. 一种基于SOI结构的电离总剂量探测系统及方法. CN106802427B[P]. 2017-06-06.

条目包含的文件

条目无相关文件。

所有评论 (0) 提交新评论/评论/提问

暂无评论

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。

个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[孙静]的文章
[郭雄]的文章
[施炜雷]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[孙静]的文章
[郭雄]的文章
[施炜雷]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[孙静]的文章
[郭雄]的文章
[施炜雷]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享

版权所有 @2018 - 2024 中国科学院新疆理化技术研究所 - Powered by CSpace

地址邮编: 新疆乌鲁木齐市北京南路40-1号（830011） 电话: 0991-3838931